

NUBIC知的財産情報開示

開示日：2001年11月26日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

NUBIC管理番号：2001000066

表題	半導体素子のゲート絶縁薄膜製造方法			
技術分野	電気・電子	情報・通信	化学・薬品	
適応製品	半導体素子の高誘電体薄膜			
目的	高集積素子における高誘電率で絶縁性の高いゲート膜の提供			
技術概要	シリコン基板上にトランジスタのゲート絶縁膜としてゾルゲル法で高誘電率の酸化ハフニウム等の超薄膜を作製し、素子のさらなる高集積化を可能とするものである。従来の絶縁薄膜の成膜方法に比し、製造工程を簡略化できるほか、絶縁膜特性も従来の物に比べて比肩する特性を有するデータが得られた。 高集積化した半導体素子、例えばDRAMにおけるゲート絶縁層、さらに高集積素子における配線や電極等における層間絶縁膜としての応用も期待できる。			

整理番号 10180 担当者 片山 充子

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。
(FAX、e-mail、郵送いずれでも可。)
各担当コーディネーターからご連絡を申し上げます。

面談希望日時			
(ふりがな) 氏名			
会社名			
所属	役職		
電話番号	FAX番号		
E-mail			
連絡事項			

【申込み・問い合わせ先】



日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL :03-5275-8139 FAX :03-5275-8328 e-mail :nubic@adm.nihon-u.ac.jp